REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE « Dr. TAHAR MOULAY » DE SAIDA

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE



Présenté en vue de l'obtention du diplôme de

MASTER

Spécialité : PHYSIQUE

Option : Physique des Matériaux

Par

CHEGOUFI WAFAA Sur le thème

Investigation théorique des propriétés structurales, électroniques et magnétiques de l'alliage Full-Heusler RbMgO₂

Soutenu le : 08/07/2021 devant le jury composé de :

Mr. Kouidri Smain	MCA	Université Dr. Tahar Moulay de Saida	Président
Mr. Abada Ahmed	MCA	Université Dr. Tahar Moulay de Saida	Encadreur
Mr. Zemouli Mostefa	MCA	Université Dr. Tahar Moulay de Saida	Examinateur
Melle. Saadaoui Fatiha	MCB	Université Dr. Tahar Moulay de Saida	Examinatrice

Année Universitaire 2020 - 2021

Dédicaces

Enfin, mon rêve de remise des diplômes est devenu réalité Je dédie cette remise de diplôme a ma chère mère et a mon cher père, que Dieu ait pitié d'eux et les remercie de rester avec moi et de se sacrifier a toutes les étapes de ma vie .et Je le dédie aussi :

- ➤ A mon cher mari qui m'a encouragé a étudier.
- ➤ A ma chère fille, Alaa, que Dieu la protège.
- ➢ A ma très chère grand −mère et mère, que Dieu la protège.
- ➢ A mon unique et cher frère Nadir.
- ➤ A tous mes enseignants du primaire à l'université.
- ➤ A toues mes amies, mes collègues et à tous ceux qui m'aiment.

Remerciements :

J'aimerais bien exprimer mon profond respect et ma reconnaissance à Dr ABADA AHMED, maitre de conférences A à l'université de Saida, qui m'a encadré et de me guider pendant l'élaboration de ce travail, je le remercie chaleureusement pour ses précieux conseils, sa disponibilité et ses qualités humaines.

De même volonté, J'adresse mes remerciements à Monsieur Kouidri Smain maitre de conférences A à l'université de Saida, qui m'a fait l'honneur d'accepter de présider le jury du mémoire.

Je tiens à remercier vivement Melle Saadaoui Fatiha, maitre de conférences B à l'université de Saida, et Monsieur Zemouli Mostefa, maitre de conférences A à l'université de Saida, qui fait part du jury et d'avoir passé leur temps précieux à examiner mon travail.

Je suis très reconnaissant à toute ma famille pour le soutien qu'elle m'a apporté Pendant toutes ces années, surtout mes chers parents.

Sommaire

Introduction générale	
Chapitre I : L'intérêt des demi-métaux	
I.1 Introduction	
I.2 Magnétorésistance05	
I.3 Electronique de spin06	
I.4 Demi-métallicité des alliages Heusler08	
I.5 L'intérêt des demi-métaux pour l'électronique de spin09	
Références11	
Chapitre II : Théorie de la fonctionnelle de la densité	
I .1 Introduction	
II.2. Approche ab-initio	
II.2.1. Equation de Schrödinger d'un cristal	
II.2.2Approximation de Born-Oppenheimer15	
II.2.3Approximation Hartree (des électrons libres)16	
II.2.4Théorie de la Fonctionnelle de la Densité	
II.2.4.1Théorèmes de Hohenberg-Kohn18	
II.2.4.2Les équations de Kohn-Sham17	
II.2.4.3. Traitement de terme d'échange et corrélation	

II.2.4.3a. Approximation de la densité locale (LDA)22
II.2.4.3b. Approximation du gradient généralisé (GGA)24
II.2.4.4. Résolution des équations de Kohn-Sham
Références27
Chapitre III : Ondes planes augmentées linéarisees
III 1 Introduction
III2La méthode des ondes planes linéairement augmentées (FP-LAPW)30
III.2-1. La méthode des ondes planes augmentées (APW)
III.2-2La méthode des ondes planes linéairement augmentées (LAPW)33
III .3Les roles des énergies de linéarisation (E_l)
III 4Développement en orbitales locales
$\blacksquare 4.1. Méthode LAPW+LO. 34$
III.4.2.Méthode APW+LO
III.5 Le concept de la méthode FP-LAPW
Ⅲ6 .Le code Wien2k36
Ⅲ6.1 . Wien2k
III.7. Conclusion
Références40

Chapitre IV	Résultats et discussions	35
IV.1. Introduction		36

Conclusion Général	45
Références	
IV.6. Effet de distorsion	44
IV.5. Propriétés magnétiques	43
IV.4.3. Densité d'états électroniques	42
IV.4.2. Origine du gap	41
IV.4.1. Structures de bandes	40
IV.4. Propriétés électroniques	
IV.3. Propriétés structurales	
IV.2. Les détails de calcul	37

Table des figures

Figure I-1 Magnétorésistance géante dans une structure à base de multicouches d'alliage cobalt-fer avec du cuivre.

Figure I-2Structure de bande pour un matériau (a) ferromagnétique conventionnel et (b) demi-métallique .

Figure I-3 diagramme expliquant l'origine de la magnétorésistance dans le cas d'un matériau ferromagnétique « classique » avec une polarisation en spin de 40 %, et dans le cas d'un demi-métal donc avec une polarisation en spin de 100 %.

Les densités d'états sont représentées pour des électrodes ferromagnétiques « classiques », et pour des électrodes demi-métalliques, dans le cas où les deux électrodes ont leurs aimantations soit parallèles soit antiparallèles. Dans le cas parallèle, on observe une résistance faible entre les deux électrodes pour les deux types de matériaux, « classiques » ou demi-métalliques. Cependant, dans le cas antiparallèle, la résistance devient élevée dans le cas du ferromagnétique « classique » alors qu'elle devient infinie (en théorie) dans le cas du demi-métal. La magnétorésistance est donc infinie en théorie dans le cas des électrodes demi-métalliques.

Figure II-1 Interdépendance des équations de Kohn-Sham

Figure II-2 Organigramme d'un calcul auto-cohérent dans une méthode basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité électronique DFT.

Figure III.1. Division de la maille élémentaire en sphères atomiques et régions interstitielles.

Figure III-2 L'organigramme du programme de wien2k.

Figure IV-1 Représentation schématique de la structure $L2_1$ pour les alliages Full Heusler de type X2YZ.

Figure IV-2 Energie totale calculée en fonction du volume pour l'alliage RbMgO2dans la structure AlCu2Mn(225) pour les états non magnétique (NM) et ferrimagnétique (FM).

Figure IV-3Energie totale calculée en fonction du volume pour l'alliage RbMgO2 dans la structure CuHg2Ti(216)pour les états non magnétique (NM) et ferrimagnétique (FM).

Figure IV-4Energie totale calculée en fonction du volume pour l'alliageRbMgO2dans les deux structures AlCu2Mnet CuHg2Ti pour l'état ferrimagnétique (FM).

Figure IV-5-a Structure de bandes calculées au paramètre d'équilibre de l'alliage RbMgO2 pour des spins majoritaires dans la structure de type AlCu2Mn.

Figure IV-6-b Structure de bandes calculées au paramètre d'équilibre de l'alliage RbMgO2 spins minoritaires dans la structure de type AlCu2Mn.

Figure IV-7 Densités des états totale et partielles des atomes O, Mg et Rb de l'alliage RbMgO₂ dans la structure de type AlCu₂Mn à l'équilibre.

Figure IV-8Les variations des moments magnétiques total, interstitiel et partiels des atomes O, Rb et Mg en fonction du paramètre de maille de l'alliage Heusler RbMgO₂ dans la structure de type AlCu $_2$ Mn .

Liste des tableaux

Tableau IV-1Rayons muffin-tin RMT des éléments constituant le composé RbMgO₂.

Tableau IV-2Les paramètres de maille d'équilibre *a*, les volumes V_0 , les valeurs d'énergie d'équilibre E_0 , le module de compression *B*, sa dérivée *B*' et l'énergie de cohésion E_{coh} des deux structuresAlCu2Mn et CuHg2Ti dans les phases FM et NM de l'alliage RbMgO2

Tableau IV-3 Les valeurs des gaps GMin(eV) et GHM(eV) calculées au paramètre d'équilibre pour la bande des spins minoritaires de l'alliage RbMgO2dans la structure de type AlCu2Mn.

Tableau IV-4Les valeurs du moment magnétique total, des moments magnétiques partiels et interstitiel du composé RbMgO2 pour la structure AlCu2Mn calculée au paramètre de maille d'équilibre. Toutes les valeurs sont en magnéton de Bohr (μB).

Tableau VI-5Les moments magnétiques total, interstitiel et partiels des atomes O Mg et Rb calculés pour le composé $RbMgO_2$ dans la structure de type AlCuMn en fonction du paramètre de maille.

Liste des abréviations

Abréviations fréquemment utilisées : **APW** : Augmented Plane Waves. APW+lo : Augmented Plane Waves + local orbitals. DFT : Density Functional Theory. DMF : Demi-Métal Ferromagnétique. DOS: Density Of States. EF: Fermi level. FM: Ferromagnetic. FP-L/APW+lo : Full Potential / Linearized Augmented Plane Waves + local orbitals. FP-LAPW : Full Potential Linearized Augmented Plane Waves. GGA : Generalized Gradient Approximation. GGA-PBE : Generalized Gradient Approximation, Perdew-Burke-Ernzerhof. GMR : Giant Magneto Résistance. HF: Hartree-Fock. HK : Hohenberg–Kohn. HMF : Half-Metal Ferromagnetic. KS: Kohn-Sham. LAPW : Linearized Augmented Plane Waves. LDA : Local Density Approximation. LSDA : Local Spin polarized Density Approximation. SCF: Self-Consistent Field. TMR : Tunnel Magneto Resistance.

XC : Exchange-Correlation potentiel.



I. Introduction générale :

L'électronique classique qui a envahi notre quotidien est basée sur le contrôle des courants de charges. Ces dernières années les chercheurs se sont orientés vers une nouvelle discipline appelée l'électronique du spin ou spintronique où en plus de la charge des électrons, leur spin est aussi pris en considération pour agir sur la mobilité des électrons et ouvrir un champ d'application sur la miniaturisation des systèmes de stockage et la détection de l'information. La spintronique a eu un grand succès en 1980 pour la multiplication considérable de la capacité de stockage des disques durs.

Les alliages Heusler ont une catégorie particulière de composés intermétalliques nommés d'après Friedrich Heusler qui, en 1903, a rapporté que le Cu_2MnAl est un matériau ferromagnétique alors que ses constituants ne le sont pas. Depuis la prédiction de la demimétallicité par de Groot et al. en 1983, de l'alliage NiMnSb, l'intérêt scientifique des alliages Heusler a été renouvelé et ces matériaux ont commencé à avoir des intérêts à la fois théoriques et expérimentaux. Plusieurs alliages Heusler ont été ensuite prédits par des calculs *ab-initio* tels que les alliages qui contiennent le Cobalt (Co) et qui sont des candidats prometteurs pour les applications de spintronique en raison de leur haute température de Curie.

Cependant pour développer ce genre de technologie, il est nécessaire d'étudier de façon plus approfondie ce type de matériaux.

Le sujet de ce mémoire s'inscrit dans ce contexte : déterminer les propriétés structurales, électroniques et magnétiques du composé Full-Heusler RbMgO₂ en se basant sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) où le traitement du potentiel d'échange et corrélation est fait par l'approximation GGA avec la méthode de FP-LAPW incorporée dans le code Wien2K.

Ce mémoire est structuré comme suit :

- Le premier chapitre présente l'intérêt des demi-métaux.

- Le deuxième chapitre est destiné au fondement de la théorie de la fonctionnelle de la densité, l'approximation de la densité locale (LDA) et l'approximation du gradient généralisé (GGA).

- Le troisième chapitre présente la méthode FP-LAPW (Full Potential-Linearized Augmented Plane Wave) dan le code Wien2k - Enfin le quatrième chapitre résume nos résultats, leurs interprétations ainsi qu'une comparaison avec un travail théorique disponible en littérature.

Cette partie est destinée à l'étude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques du composé RbMgO₂.



I. L'intérêt des demi-métaux :

I.1. Introduction :

L'électronique de spin profite du spin de l'électron pour transporter l'information. Les jonctions magnétiques tunnels sont considérées comme des candidats prometteurs pour la prochaine génération de composants spintroniques car elles présentent de larges taux de magnétorésistance tunnel (TMR)à température ambiante. Récemment, des taux de TMR excédant les 500% ont été obtenus en utilisantdes barrières tunnels. D'autre part, ces dernières années le retournement de l'aimantation par courant polarisé en spin, en utilisant le couple de transfert de spin, a été mis en évidence. Dans ce mode de retournement à base de transfert de spin, la densité de courant est proportionnelle à la constante d'amortissement de Gilbert et inversement proportionnelle à la polarisation en spin. Le développement de la spintronique nécessite par conséquent l'utilisation de matériaux à forte polarisation en spin et avant de faibles coefficients d'amortissement. Les demi-métaux, caractérisés par un taux de 100% de polarisation en spin au niveaude Fermi (Figure I.2.b) présentant ainsi une faible résistance pour un type de spin et une grande résistance pour l'autre type de spin, possèdent donc un énorme potentiel pour être utilisés dans les composants spintroniques comme la logique magnétique et les mémoires magnétiques à accès aléatoires (MRAM). Ces matériaux sont donc des sources idéales pour les courants fortement polarisés en spin permettant de réaliser des taux de magnétorésistance très élevés, une faible densité de courant de retournement d'aimantation dans les dispositifs à base de transfert de spin, et pour une injection efficace de spin dans les semi-conducteurs. Théoriquement, certains types de matériaux, tels que $Fe_3O_4[1,2]$ CrO₂[3], les pérovskites à valence mixte [4] et les alliages Heusler[5, 6], ont été prédits comme étant des demi-métaux. En outre, cette propriété demimétallique a été démontrée expérimentalement à basse température. Toutefois, les oxydes demimétaux ont une faible température de Curie et donc la polarisation en spin doit être dérisoire à température ambiante. Les alliages Heusler, par contre, sont des matériaux prometteurs pour les applications spintroniques, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont généralement des températures de Curie très élevées [7] et offrent donc une possibilité de posséder le caractère demi-métallique même à température ambiante. De plus, ils jouissent d'une structure cristallographique compatible avec celle des matériaux semi-conducteurs utilisés dans l'industrie et leurs champs coercitifs sont très faibles.

I. 2. Magnétorésistance

Le premier effet caractéristique de la spintronique a été la magnétorésistance géante (GMR pour Giant Magneto-Resistance). Elle a été découverte en 1988 à Orsay par l'équipe d'Albert Fert **[8]**. Dans des structures alternant un métal magnétique et un métal non magnétique, un changement de résistance important est observé lorsque, sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, les aimantations macroscopiques des couches magnétiques successives basculent d'un état antiparallèle à un état parallèle. La figure I-1 montre la variation de la résistance dans une telle structure entre les deux cas extrêmes d'alignement. Des structures plus complexes ont ensuite été développées pour augmenter la sensibilité de l'élément magnéto résistif. Il s'agit de ce qu'on appelle des vannes de spin.

La magnétorésistance géante est l'outil adéquat pour détecter des champs magnétiques de très faible amplitude. L'application principale a été développée dans les années 90. Elle concerne les têtes de lecture pour disques durs où un petit élément magnéto résistif détecte la variation de champ magnétique généré parles transitions entre bits de données dans un support d'information et transcrit l'information sous la formede pulses électriques images du changement de résistance. Aujourd'hui, la totalité de la production mondiale des têtes de lecture/ écriture pour disques durs est constituée de têtes magnéto résistives de type vannesde spin.



Figure I-1 Magnétorésistance géante dans une structure à base de multicouches d'alliage cobalt-fer avec du cuivre.

Un autre effet de magnétorésistance similaire à la GMR a été observé dans desjonctions tunnel métal / isolant/ métal, dans lesquelles les deux électrodes métalliques sont magnétiques, d'où le nomde magnétorésistance tunnel (TMR pour Tunnel Magneto-Resistance) [9].Une variation importante de la résistance de la jonction est observée lorsque les directions relatives des aimantations des couches ferromagnétiques varient.

La forte variation de magnétorésistanceà température ambiante, trois fois supérieureà la magnétorésistance géante, permet d'utiliser ces structures comme cellules de stockagedansdes mémoires non volatiles à accès aléatoire. Dans ces mémoires, appelées MRAM (Magnetic Random Access Memories), l'information n'est plus stockée sous la formed'une charge dans une capacité, comme c'est le cas des mémoires semi-conductrices de type DRAM ou Flash, mais sous la forme d'une direction d'aimantation dans la jonction tunnel magnétique.

Paradoxalement, en parallèle avec l'expansion vertigineuse des composants (spin)électroniques,les mécanismes physiques en jeu sont encore mal compris. Bien que le comportement « macroscopique »de la GMR et de la TMR soit identique, le mécanisme physique à l'origine de chacun est différent. Il apparaît que la magnétorésistance tunnel dépend principalement de l'asymétrie de spin, mais également de la structure électronique de l'isolant et du caractère des liaisons électroniques à l'interface métal / isolant. Un autre enjeu important émerge alors qui concerne la recherche de matériaux ferromagnétiques demi-métalliques, dans les quels un seul type de spin est présent, et donc une asymétrie de spin de 100%.

I.3. Electronique de spin :

La GMR a permis la réalisation de ce que l'on pourrait appeler une « vanne de spin » commandée par champ magnétique. En effet, il suffit d'employer deux couches magnétiques astucieusement choisies : l'une, appelée « couche dure », insensible, «n'obéissant pas » à un champ magnétique externe ; l'autre, appelée « couche douce »,« obéissant », au contraire et voyant son aimantation tourner en fonction de l'intensité du champ magnétique extérieur. Ainsi, en fonction de son orientation, un champ magnétique externe va imposer au système une configuration parallèle ou antiparallèle: l'alignement relatif des deux filtres à spinet donc la valeur de la résistance électrique sont alors directement sensibles à l'intensité du champ magnétique très sensible.

Ce genre de capteur est employé dans les têtes de lecture des ordinateurs pour lire les bits magnétiques enregistrés sur les disques durs. Chaque année plus de 600millions de têtes de lecture GMR sont fabriquées par l'industrie informatique. Dans la mesure où ses capteurs sont très petits, la densité des bits magnétiques peut être très élevée. Cela a justement conduit depuis une dizaine d'années à une augmentation très importante de la capacité des disques durs. Il s'agit d'une des applications de cette nouvelle branche de l'électronique que l'on appelle pour des raisons évidentes l'électronique de spin ou spintronique [10].

I.4.Demi-métallicité des alliages Heusler

Le terme de demi-métallicité a été introduit pour la première fois par de Groot et al [11], en s'intéressant au calcul de la structure de bande d'alliages demi-Heusler : NiMnSb[11]. Les matériaux ferromagnétiques conventionnels présentent une densité d'états électronique (N(E_F)) au niveau de Fermi pour les électrons de spin majoritaires (up : N \uparrow (E_F)) et de spin minoritaires (down : N \downarrow (E_F)). Nous pouvons alors définirla polarisation P en spin, qui mesure l'asymétrie en spin, par l'expression [12]:

$$p = \frac{N \uparrow (E_F) - N \downarrow (E_F)}{N \uparrow (E_F) + N \downarrow (E_F)}$$

Les matériaux demi-métalliques (P=1) montrent des propriétés de conduction complètement différentes entre spins minoritaires et spins majoritaires. Ils présentent ainsi une propriété métallique pour une direction de spin (densité d'état non-nulle au niveau de Fermi) et une propriété semi-conductrice ou même isolante pour l'autre direction de spin et par conséquent un taux de polarisation en spin de 100%.



Figure I- 2 Structure de bande pour un matériau (a) ferromagnétique conventionnel et (b) demi-métallique

Depuis l'étude de Groot[11], un grand nombre de composés, tels que les alliages Heusler, $CrO_2[13]$ ou le graphène[14] sont prédits comme étant des demi-métaux. Grâce aux propriétés de conduction, les matériaux demi-métalliques peuvent potentiellement posséder une polarisation en spin de 100%, envisageant alors de forts effets magnétorésistifs (magnétorésistance tunnel et magnétorésistance géante).

La structure électronique joue un rôle important dans la détermination des propriétés magnétiqueset de demi-métallicité des alliages Heusler, par conséquent, les calculs de structure de bande prennent une place importante. Après les premières synthèses des alliages Heusler à base de cobalt, dans les années 70, les premières indications de demi-métallicité sont rapportées sur les couches de Co₂MnAl et de Co₂MnSn par Kübler[**15**] et de Co₂MnSi, Co₂MnGe par Ishida[**16**]. Le composé Co₂FeSi [**17,18**]présente aussi, expérimentalement et théoriquement, un comportement demi-métallique.

Les alliages Heusler sont généralement connus sous la forme de composés ternaires mais ils peuvent aussi être sous forme quaternaire comme, par exemple, les alliages Co_2 Fe(Al, Si) [18] et Co_2 (Fe, Cr)Al [19,20].Gercsiet *al.* [18] ont étudié les alliages à base de cobalt, deforme quartenaire tel quele Co_2 FeSi_{1-X}Al_x et ont montré que la largeur de la bande interdite (gap) de spin minoritaire diminue avec l'addition de l'Al.

I.5.L'intérêt des demi-métaux pour l'électronique de spin :

Dans ce paragraphe, nous allons montrer quel est l'intérêt des demi-métaux pour l'électronique de spin. Intéressons-nous au cas des jonctions tunnel magnétiques, dans le cas où les deux électrodes sont des électrodes ferromagnétiques classiques (non demi-métalliques) et dans le cas où ces deux électrodes ferromagnétiques sont demi-métalliques.

Si l'on considère que le spin de l'électron est conservé lors du processus tunnel, les électrons de spin« up » et de spin « down » peuvent traverser la barrière tunnel de manière indépendante. On peut donc modéliser la conduction dans la jonction tunnel par un réseau de deux résistances électriques en parallèle, où chaque résistance correspond à un canal de spin (Tisuan 2000). La résistance totale va différer selon que les aimantations des deux électrodes sont en configuration parallèle ou antiparallèle. On suppose également que la conductivité est proportionnelle au produit des densités d'états de chaque côtéde la barrière sans tenir compte de la probabilité de transmission par effet tunnel pour les électrons de chaque direction de spin. Intéressons-nous à la **figure I-3**: dans le cas d'un matériau ferromagnétique classique, pour lequel les deux électrodes ont leur aimantation dans une configuration parallèle (**figure I-3-A**), les densités d'états de spin « up » sont majoritaires dans les deux électrodes. Le courant de spin est donc important et la résistance de ce canal est faible. Les densités d'états de spin « down » sont minoritaires dans les deux électrodes, ainsi le courant de spin est faible et donc la résistance est élevée pour ce canal de spin. La résistance totale de la jonction, qui provient des résistances des deux canauxde spin mises en parallèle, est donc faible.

Dans la configuration antiparallèle (**figure I-3-B**), les électrons de spin « up » ou « down »sont majoritaires pour une électrode, mais minoritaires pour l'autre, et vice-versa. Les résistances correspondant à chaque canal de spin sont élevées, ainsi que la résistance totale de la jonction. C'est l'existence de ces deux états de résistance, faible ou élevée, qui permet l'utilisation des jonctions tunnel magnétiques dans des mémoires ou des capteurs.



FigureI-3Diagramme expliquant l'origine de la magnétorésistance dansle cas d'un matériau ferromagnétique « classique » avec une polarisation en spin de 40 %, et dansle cas d'un demimétal donc avec une polarisation en spin de 100 %. Les densités d'états sont représentées pour des électrodes ferromagnétiques « classiques », et pour des électrodes demi-métalliques, dans le cas où les deux électrodes ont leurs aimantations soit parallèles soit antiparallèles. Dans le cas parallèle, on observe une résistance faible entre les deux électrodes pour les deux types de matériaux, « classiques » ou demi-métalliques.

Cependant, dans le cas antiparallèle, la résistance devient élevée dans le cas du ferromagnétique « classique » alors qu'elle devient infinie (en théorie) dans le cas du demi-métal. La magnétorésistance est donc infinie en théorie dans le cas des électrodes demi-métalliques.

Dans le cas où les deux électrodes sont demi-métalliques, et en configuration parallèle(**figure I-3-C**), il existe un canal de spin permettant le passage des électrons. La résistance est donc faible. Par contre, dans le cas d'une configuration antiparallèle (**figure I-3-D**), il n'y a aucun courant de spin car il n'y a pas d'état disponible soit au départ, soit à l'arrivée. La résistance est alors infinie en théorie. Ainsi, dansle cas d'un demi-métal, on s'attend en théorie à une magnétorésistance tunnel infinie.

Références

[1] A. Yanase and K. Siratori, "Band Structure in the High Temperature Phase of Fe₃O₄," *J. Phys. Soc. Jpn.*, vol. 53, no. 1, pp. 312–317, Jan. 1984.

[2] Z. Zhang and S. Satpathy, "Electron states, magnetism, and the Verwey transition inmagnetite," *Phys. Rev. B*, vol. 44, no. 24, pp. 13319–13331, Dec. 1991.

[3] K. Schwarz, "CrO₂ predicted as a half-metallic ferromagnet," *J. Phys. F Met. Phys.*, vol.16, no. 9, pp. L211–L215, Sep. 1986.

[4] J.-H. Park,, Vescovo E., Kim H.-J., Kwon C., Ramesh R., and Venkatesan T., "Directevidence for a half-metallic ferromagnet," *Nature*, vol. 392, pp. 794–796, Apr. 1998.

[5] H. C. Kandpal, G. H. Fecher, and C. Felser, "Calculated electronic and magneticproperties of the half-metallic, transition metal based Heusler compounds," *J. Phys.Appl. Phys.*, vol. 40, no. 6, pp. 1507–1523, Mar. 2007.

[6] R. A. de Groot and F. M. Mueller, "New Class of Materials: Half-MetallicFerromagnets," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 50, no. 25, pp. 2024–2027, Jun. 1983

[7] S. Trudel, O. Gaier, J. Hamrle, and B. Hillebrands, "Magnetic anisotropy, exchange anddamping in cobalt-based full-Heusler compounds: an experimental review," *J. Phys.*

[8] Le magazine d'information de l'université Paris-Sud, janvier – février numéro 69 (2008).

[9] M. Jullière, Phys. Lett. A 54, 225 (1975).

[10] C: \ Documents and Settings \ pc \ Bureau \ mémoire chapitre1 \ Le prix Nobel de physique
2007 la magnétorésistance géante - Dossiers - Science_ gouv_ fr.mht.

[11] R. A. de Groot and F. M. Mueller, "New Class of Materials: Half-Metallic Ferromagnets," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 50, no. 25, pp. 2024–2027, Jun. 1983.

[12] M. Hehn, F. Montaigne, and A. Schuhl, "Magnétorésistance géante et électronique de spin."Techniques de l'Ingénieur l'expertise technique et scientifique de référence, 10- Nov 2002.

[13] J. M. D. Coey and M. Venkatesan, "Half-metallic ferromagnetism: Example of CrO₂ (invited)," *J. Appl. Phys.*, vol. 91, no. 10, p. 8345, 2002.

[14] Y.-W. Son, M. L. Cohen, and S. G. Louie, "Half-metallic grapheme nanoribbons," *Nature*, vol. 444, no. 7117, pp. 347–349, Nov. 2006.

[15] J. Kübler, A. William, and C. Sommers, "Formation and coupling of magnetic moments in Heusler alloys," *Phys. Rev. B*, vol. 28, no. 4, pp. 1745–1755, Aug. 1983.

[16] S. Ishida, T. Masaki, S. Fujii, and S. Asano, "Theoretical search for half-metalliic films of Co₂MnZ (Z= Si, Ge)," *Phys. B Condens. Matter*, vol. 245, no. 1, pp. 1–8, Jan. 1998.



Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)

II-2Introduction

La description quantique non-relativiste d'un système moléculaire ou cristallin est basée sur l'équation de Schrödinger. Une introduction à ce formalisme débute nécessairement par la présentation de l'équation de Schrödinger exacte ("équation à plusieurs corps") qui sera simplifiée ultérieurement par diverses approximations de manière à ce qu'elle puisse être résolue. Le traitement de ce "problème à plusieurs corps" en mécanique quantique consiste à rechercher les solutions de l'équation de Schrödinger.

Malheureusement, les électrons et les noyaux qui composent les matériaux constituent un système a plusieurs corps fortement interagissant et ceci rend la résolution de l'équation de Schrödinger extrêmement difficile.

II. 2. Approches *ab-initio*

II.2.1. Equation de Schrödinger d'un cristal

Les solides sont constitués par une association de particules élémentaires : les ions (noyaux) lourds de charge positive et les électrons légers de charge négative. Le problème général est d'essayer de calculer toutes les propriétés de ces particules (ions + électrons) a partir des lois de la mécanique quantique, a l'aide de l'équation de Schrödinger:

$$H\Psi = E\Psi$$
(II -1)

Tel que E est l'énergie totale du système, décrit par la fonction d'onde Ψ du cristal. H est l'opérateur hamiltonien exact d'un cristal qui résulte de la présence des forces électrostatiques d'interaction : répulsion ou attraction suivant la charge des particules (ions, électrons). Le problème général peut être pose sous la forme d'une équation du mouvement de toutes les particules présentes dans le cristal. L'hamiltonien exact du cristal (non relativiste) résulte de la présence des forces électrostatiques d'interaction : Répulsion ou attraction suivant la charge des particules (ions, électrons) **[1].**

$$H_{tot} = T_e + T_N + V_{e-e} + V_{N-N} + V_{e-N}$$
(II-2)

$$\mathbf{H} = \left[-\sum_{I}^{A} \frac{h^{2}}{2m} \nabla_{I}^{2} - \sum_{i,I} \frac{Z_{I} e^{2}}{|\vec{r}_{i} - \vec{R}_{I}|} + \frac{1}{2} \sum_{i < j} \frac{e^{2}}{|\vec{r}_{i} - \vec{r}_{j}|} + \frac{1}{2} \sum_{I < j} \frac{Z_{I} Z_{j} e^{2}}{|\vec{R}_{I} - \vec{R}_{j}|} \right]$$

Dans laquelle les termes T_e , T_N , V_{e-e} , V_{N-N} et V_{e-N} correspondent respectivement :

• $T_e = -\frac{h^2}{2m} \sum_i \Delta_i$ est l'énergie cinétique des électrons • $T_N = -\frac{h^2}{2m} \sum_k \Delta_k$ est l'énergie cinétique des noyaux • $V_{e-e} = \frac{1}{2} \sum_i i, j \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$ Interaction répulsive (électron -électron) • $V_{N-N} = \frac{1}{2} \sum_i l, k \frac{e^2 z_{kz_l}}{|\vec{R}_l - \vec{R}_k|}$ Interaction répulsive (noyaux – noyaux) • $V_{e-N} = \frac{1}{2} \sum_i i, k \frac{e^2 z_k}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{R}_k - \vec{r}_i|}$ Interaction attractive (noyaux – électron)

e : la charge de l'électron.

m : la masse de l'électron

M : masse de noyau

 \vec{r}_i, \vec{r}_j : définissent les positions des électrons (i) et (j), respectivement.

 \vec{R}_k , \vec{R}_i : définissent les positions des noyaux (k) et (l), respectivement.

 \vec{Z}_k , \vec{Z}_l : sont les nombres atomiques des noyaux (k) et (l), respectivement.

Donc on peut écrire l'équation (II-1) qui conduit à l'évolution d'un problème à N corps qui n'est accessible qu'au prix de certaines approximations. Ces dernières doivent refléter une certaine réalité physique.

II. 2. 2 Approximation de Born-Oppenheimer

Suivant *Born* et *Oppenheimer* [2], on commence par négliger le mouvement des noyaux par rapport à celui des électrons. Elle est justifiée par le fait que la masse des noyaux est plus de trois ordres de grandeur supérieure à celle des électrons. Alors

les électrons se déplacent donc plus rapidement que les noyaux atomiques. On néglige ainsi l'énergie cinétique *TN* des noyaux et l'énergie potentielle noyaux-noyaux V_{N-N} devient une constante qu'on peut choisir comme la nouvelle origine des énergies. L'hamiltonien total (II-2) peut alors être remplace par l'hamiltonien électronique suivante [2] :

$$H_{tot} = T_e + V_{N-e} V_{e-e} \tag{II-3}$$

L'équation de Schrödinger est donc réécrite de la façon suivante :

$$H_e = E_e \Psi_e \tag{II} -$$

Avec $\Psi_e \ et \ E_e$: l'état propre et l'énergie propre du système de N_e électrons : E_{total} : l'énergie totale du système est alors donnée par :

$$E_{tot} = E_{e+} E_N \tag{II-5}$$

Bien que le problème soit grandement simplifie, la résolution exacte de (II.5) est toujours impossible. Cependant il est possible d'accéder à l'état fondamental du système, l'énergie associée répondant à un principe variationnel. En effet l'état fondamental du système de N_e électrons est par définition l'état qui minimise l'énergie E_e . C'est dans la recherche de minimum d'énergies que les techniques *ab-initio* vont intervenir.

II.2.3 Approximation Hartree (des électrons libres)

L'approximation de Hartree **[3]** consiste à chercher les fonctions propres de l'hamiltonien H sous la forme approchée :

$$\Psi_{appro} = \Psi_{1(r_1)} \cdot \Psi_{2(r_2)} \cdot \Psi_{N(r_N)}$$
 (II-6)

Cette approximation est basée sur l'hypothèse d'électrons libres ce qui revient à ne pas tenir compte des interactions entre les électrons et des états de spin. Ceci a deux conséquences importantes :

- La répulsion coulombienne totale du système électronique est surestimée.

4)

- Le principe d'exclusion de *Pauli* n'est pas pris en compte

Cette seconde conséquence étant plus grave que la première, l'approximation de «Hartree-Fock » **[4]** a été introduite pour prendre en compte le spin des électrons pour la résolution de l'équation de Schrödinger. L'énergie moyenne électronique est obtenue par minimisation de l'opérateur Hamiltonien par la méthode variationelle:

$$\langle H \rangle = \frac{\langle \Psi | H | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$$
 (II-7)

Le calcul variationnel montre que chaque fonction d'onde $\Psi(r)$ doit, pour rendre minimale l'énergie moyenne $\langle H \rangle$, être elle-même solution d'une équation différentielle du second ordre qui a la forme d'une équation de Schrödinger à une particule :

$$[-\nabla^{2} + w(r) + U_{i}(r)] \Psi_{i}(r) = E_{i} \Psi_{i}(r)$$
(II-8)

Le premier terme potentiel W(r) d'équation (II -8) est issu directement du hamiltonien H. Il représente l'interaction coulombienne de l'électron avec tous les noyaux du cristal et il possède la périodicité du réseau de Bravais.

Le second terme potentiel U(r) de l'équation (II -8) appelé potentiel moyen autocohérent représente la répulsion coulombienne exercée sur l'électron i par tous les autres électrons j \neq i, chacun étant dans son état Ψ j :

$$U_{i}(r) = \iiint \frac{q^{2} \rho_{i(\dot{r})}}{|r - \dot{r}|} d^{3} \dot{r}$$
(II-9)

où

$$\rho_i(\hat{r}) = \sum j = i \left| \Psi_i(\hat{r}) \right|^2 \tag{II-10}$$

Pour chaque densité électronique au point r', il existe N équations de la forme (II -8), toutes différentes et couplées entre elles par les différents potentiels U(r). Le calcul est donc sans solution en pratique si l'on ne procède pas à des approximations supplémentaires. Par conséquent, il faut résoudre l'équation par approximations successives, jusqu'à ce qu'il y ait auto-cohérence des solutions trouvées.

II. 2. 4. La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT)

Résoudre l'équation de Schrödinger avec N électrons doit utiliser des méthodes approximatives qui permettent de reproduire le plus exactement les quantités physiques contenant le plus d'informations. La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) offre ainsi des perspectives intéressantes puisque, en principe, elle permet d'obtenir la densité électronique ρ et l'énergie totale du système exactement.

La méthode est basée sur le postulat proposé par Thomas et Fermi [5,6] à la fin des années 30. Il stipule que les propriétés électroniques peuvent être décrites en terme de fonctionnelles de la densité électronique ρ définie sur l'espace usuel R^3 .

La densité électronique $\rho(\mathbf{r})$ étant la probabilité de présence d'un électron dans un volume unitaire en r. Cette quantité est définie de la façon suivante [7]

$$\rho(r_1) = N \int \text{toutéspace} \int \text{toutéspace} \Psi^*(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N) \Psi(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N) \, \mathrm{d}\vec{r}_1 \dots \mathrm{d}\vec{r}_N \qquad (\text{II-11})$$

et :

$$N = \int \rho(\vec{r}) d\vec{r}$$
 (II-12)

Cette propriété, sur laquelle se base les techniques du calcul DFT, a été démontré par Pierre Hohenberg et Walter Kohn (prix Nobel de chimie en 1998).

II. 2. 4. 1. Théorèmes de Hohenberg-Kohn

Le formalisme de base de la DFT est basé sur le théorème de *Hohenberg-Kohn* (1964) **[8].** Cette approche s'applique pour tout système à plusieurs particules en interaction évoluant dans un potentiel externe. Elle repose sur deux théorèmes :

Théorème 1: Ce théorème montre que la densité électronique $\rho(r)$ est la seule fonction nécessaire pour obtenir toutes les propriétés électroniques d'un système quelconque. En d'autres termes, il existe d'une correspondance biunivoque entre la densité

électronique de l'état fondamental $\rho_0(r)$ et le potentiel externe $V_{ext}(r)$ et donc entre $\rho_{fond}(r)$ et la fonction d'onde de l'état fondamental Ψ_{fond} .

$$\mathbf{E} = E[\rho_{fond}] = F_{HK}[\rho_{fond}] + \int V_{e-N}(r)\rho(r)\mathbf{d}(r) \qquad (\text{II-13})$$

avec

$$F_{HK}[\rho_{fond}] = T[\rho] + V[\rho]$$
(II-14)

où : $F_{HK}[\rho_{fond}]$ la fonctionnelle de Hohenberg et Kohn.

- > $T[\rho]$: L'énergie cinétique
- \blacktriangleright *V*[ρ]: L'interaction électron-électron.

Nous savons que la densité électronique de l'état fondamental est suffisante pour obtenir toutes les propriétés de cet état mais comment savoir si une densité quelconque est celle de l'état fondamental ? Ceci est l'objet du deuxième théorème de Hohenberg et Kohn

Théorème2 : Ce théorème montre que la fonctionnelle d'énergie $E[\rho]$ est minimum quand une densité électronique quelconque $\rho[r]$ correspond à la densité électronique de l'état fondamental $\rho_{fond}(r)$.

$$E(\rho_{fond}) = Min E(\rho) \tag{II-15}$$

. .

C'est-à-dire, d'après le premier théorème, une densité électronique d'essai ρ_{test} définit son propre hamiltonien et de même sa propre fonction d'onde d'essai Ψ_{test} . A partir de là, nous pouvons avoir une correspondance entre le principe variationnel dans sa version fonction d'onde et dans sa version densité électronique telle que :

$$\langle \Psi_{test} | H | \Psi_{test} \rangle = E | \rho_{test} | \ge E_{fond} = \langle \Psi_{fond} | H | \Psi_{fond} \rangle$$
 (II-16)

En résume : toutes les propriétés d'un système défini par un potentiel externe V_{ext} peuvent être déterminées à partir de la densité électronique de l'état fondamental. L'énergie du système E(r) atteint sa valeur minimale si et seulement si la densité électronique est celle de l'état fondamental. Cependant, il reste un problème de taille à régler, comment réécrire une formulation analytique exacte de la fonctionnelle $F_H[\rho]$ pour un système à *N* électrons interagissant.

II. 2. 4. 2. Equations de Kohn-Sham :

En 1965 *Walter Kohn* et *Lu Sham* [9] proposent une méthode pratique permettant d'utiliser la théorie de la fonctionnelle de la densité. Tout d'abord ils supposent qu'il existe un système fictif de N électrons indépendants ayant la densité dans son état fondamental $\rho_{fond}(r)$.

L'intérêt vient du fait que les expressions de l'énergie cinétique et de l'énergie potentiel pour ce système fictif sont connues. Puis, ils montrent que pour qu'il en soit ainsi, ces électrons doivent être plongés dans un potentiel extérieur effectif, c'est la première équation de *Kohn-Sham* (*K.S*) $V_{eff}[\rho(r)]$:

$$V_{eff(r)} = V_{e-n(r)} + V_{Hatree}(r) + V_{xc}\rho(r)$$
(II-17)

avec $V_{Hatree}(r)$ le potentiel de Hartree qui définie par :

$$V_{Hatree}(r) = \rho \frac{\rho(\vec{r})dr}{|\vec{r} - \vec{r}|}$$
(II-18)

et V_{xc} le potentiel d'échange et corrélation:

$$V_{xc[\rho(\vec{r})]} = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta_{\rho}(\vec{r})}$$
(II-19)

Dans cette expression (II-19) E_{xc} est l'énergie d'échange-corrélation, qui regroupe tout ce qui n'est pas connu dans le système, à savoir les effets de corrélations dues à la nature quantique des électrons. Ce terme définie par :

$$E_{xc}[\rho] = F_{HK}[\rho] - \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0} \int d^3 \acute{r} \frac{\rho(\acute{r})\rho(\vec{r})}{\left|\vec{r} - \vec{\dot{r}}\right|} - T_{founde}[\rho]$$
(II-20)

 $T[\rho]$ est l'énergie cinétique des électrons de *Kohn-Sham* et le second terme le terme électrostatique de Hartree.

Pour calculer la densité électronique ρ_{fond} et l'énergie E du système, ils ont ainsi remplacé le problème de départ :

$$\mathbf{E} \begin{cases} \mathbf{H} \Psi = E_{j} \Psi_{j} \\ \rho_{fond \ (\vec{r})} = \int d^{3} r_{2} \dots d^{3} r_{N} |\Psi_{fond} \ (\vec{r}, \vec{r}_{2} \dots \vec{r}_{N})|^{2} \end{cases}$$
(II-21)

par le problème plus simple :

$$\begin{split} \dot{E} \{ H_{ks\varphi j} \left(\vec{r} \right) &= \varepsilon_j \varphi_{j\left(\vec{r} \right) \leftrightarrow} \left(-\frac{h^2}{2m} \nabla^2 + V_{eff} \right) \varphi_j(\vec{r}) = \varepsilon_j \varphi_j(\vec{r}) \rho_{fond}(\vec{r}) = \\ \sum_j^n &= \mathbf{1} \left| \psi_j(\vec{r}) \right|^2 \end{split}$$
(II-22)

Le problème E' est plus simple que le problème E car : On a résout une équation de *Schrödinger* à une seule particule (mono-électronique) utilisant le potentiel V_{eff} qui permet d'obtenir la seconde équation de *Kohn-Sham* à N_e états φ_j .

On donne l'expression de la densité électronique en fonction des N_e fonctions d'onde φ_j . C'est la troisième équation de *Schrödinger*.

Ces trois équations interdépendantes doivent être résolues de manière auto-cohérente afin de trouver la densité de l'état fondamental (Figure II -1). Tous les calculs de type DFT sont basés sur la résolution itérative de ces équations. Notons que pour la DFT, seules l'énergie totale, l'énergie de Fermi et la densité électronique ont un sens physique. Les états et les énergies de *Kohn-Sham* ne sont que des intermédiaires de calcul. Néanmoins, ils sont utilisés dans de nombreux travaux scientifiques, pour calculer certaines grandeurs comme les structures de bande.

Chapitre IIThéorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)Première équation de Kohn-Sham $V_{eff}[\rho(r)] = V_{e-n}(r) + V_{hartree}(r) + V_{xc}[\rho(r)]$ $\rho(r)$ $V_{eff}[\rho(r)]$ p(r) $V_{eff}[\rho(r)]$ Deuxième équation de Kohn-Sham $\rho(r) = \sum_{i=1}^{N^o} |\Phi_i(r)|^2$ $\Phi_{i(r)}$

Figure. II. I. Interdépendance des équations de Kohn-Shan

II. 2. 4. 3. Traitement de terme d'échange et corrélation

La théorie de la fonctionnelle de la densité appliquée dans le cadre de l'approche orbitélaire de *Kohn-Sham* demeure exacte dans son formalise. Progressivement, la partie inconnue dans la fonctionnelle $E[\rho]$ a été réduite à une fonctionnelle universelle $F_H[\rho]$ et finalement à une énergie d'échange et corrélation $E_{xc}[\rho]$.

A ce stade, il est nécessaire d'approcher l'expression de cette fonctionnelle d'échange et corrélation qui repose sur un certain nombre d'approximations :

II. 2. 4. 3. a. Approximation de la densité locale (LDA)

L'approximation de la densité local ou LDA **[10]** considère le potentiel d'échange et corrélation comme une quantité locale, définie en un point r, dépendant faiblement des variations de la densité autour de ce point r **[11,12]**. Ainsi, en un point r auquel correspond une densité $\rho(r)$, il sera associé un potentiel d'échange et corrélation comparable à celui d'un gaz homogène d'électrons de même densité $\rho(r)$. L'énergie d'échange et corrélation $E_{xc}^{LDA}[\rho]$ s'exprime alors de la manière suivant :

$$E_{xc}^{LDA}[\rho] = \int \rho(r) \rho_{xc}[\rho(r)] d^3r \qquad (\text{II-23})$$

où : ε_{xc} représente l'énergie d'échange et corrélation pour une particule d'un gaz homogène d'électrons de densité ρ . Elle peut-être considérer comme la somme d'une contribution d'échange et corrélation :

$$E_{xc} = -\frac{3}{4} \left(\frac{3}{\pi} \rho(\vec{r})\right)^2 \tag{II-24}$$

La partie corrélation $\varepsilon(\rho)$ ne peut être exprimée de manière exacte. L'approximation de ce terme est basée sur l'interpolation de résultats de calculs Monte-Carlo quantique de Ceperley et Alder (1980) [14]. Aujourd'hui, il existe dans la littérature des paramétrisations, numériques ou analytiques de $\varepsilon(\rho)$ comme celle de Hedin et Lundqvist (1971) [15] ou Perdew et al [16].

En utilisant la LDA (II.23) pour une molécule ou un solide on suppose implicitement que l'on peut obtenir l'énergie d'échange-corrélation pour un système inhomogène en considérant le gaz d'électrons comme homogène dans des portions infinitésimales de celui-ci. On peut alors appliquer localement à ces régions les résultats du gaz homogène et la sommation de ces contributions individuelles $\rho(r)\varepsilon_{xc}(\rho)dr$ donne une valeur approchée de l'échange-corrélation du système inhomogène.

Il va de soi que la validité de LDA suppose des systèmes où la densité électronique ne varie pas trop rapidement. L'efficacité de cette approximation est apparue a partir des années 1977 avec les travaux de Zunger et Freeman [17,18], ainsi que ceux de Moruzzi et al (1978) [19].

Enfin, notons qu'un précurseur de la LDA a ete introduit par Slater en 1951 **[20]** où il proposa la méthode $X\alpha$ comme une simplification de la méthode Hartree-Fock. Cette simplification aboutit a l'equation suivante :

$$\left(-\frac{h^2}{2m_e}\overline{\Delta}_j^2 + V_{e-N}(r) + V_{Hartree}(\vec{r}) + V_{X\alpha}^{LDA}(\vec{r})\right)\boldsymbol{\varphi}_j(\vec{r}) + \boldsymbol{\varepsilon}_j\boldsymbol{\varphi}_j(\vec{r}) \qquad (\text{II-25})$$

avec le potentiel local $V_{X\alpha}$:

$$V_{X\alpha}(\rho) = -\frac{3}{4}\alpha (\frac{3}{\pi}\rho(\vec{r}))^{\frac{1}{3}}$$
(II-26)

Dans l'équation (II.26), α désigne un paramètre qui a été initialement pris comme étant égal à 1. Par la suite il a été évalué pour tous les atomes neutres par Schwarz [21]. Il faut aussi noter que Kohn et Sham ont réalisé que l'équation était équivalente à la LDA, si la corrélation était ignorée et si en plus $\alpha=2/3$. La méthode X α peut donc être considérée comme un formalisme de fonctionnelle de densité, qui néglige la corrélation et dont l'énergie est donnée par :

$$E_X^{LDA} = -\frac{9}{8} \alpha \left[\frac{3}{4}\right]^{\frac{1}{3}} \int \rho(r)^{\frac{1}{3}} d\vec{r}$$
(II-27)

II. 2. 4. 3. b. Approximation du gradient généralisé (GGA)

La plus grande source d'erreur de la LDA provient de l'énergie d'échange qui est souvent sous-estimée tandis que l'énergie de corrélation est souvent surestimée même si, en valeur absolue, sa contribution à l'énergie totale est plus petite. Ces deux erreurs ont tendance à s'annuler. Pour améliorer la précision des calculs DFT, nous avons besoin de meilleures approximations pour la fonctionnelle d'échange-corrélation. Certains auteurs ont eu l'idée de définir une fonctionnelle de la densité qu'ils ont associée à ses dérivées propres dans le but de prendre en compte l'inhomogénéité du système. Dans un premier temps, la LDA fut traitée comme le premier terme d'un développement en série de *Taylor* :

$$E_{Xc}^{GEA} = \int \varepsilon_{xc}^{GEA} \left(\rho(r) \right) \rho(r) dr + \int C_{xc} \left(\rho(r) \right) \frac{|\Delta_{\rho(r)}|}{\rho^{\frac{3}{4}}(r)} dr + \cdots$$
(II-28)

Cette forme de fonctionnelle est l'approximation du gradient (GEA ou *Gradient Expansion Approximation* en anglais). Malheureusement, ceci donne de plus mauvais résultats que la LDA. En effet, le trou d'échange-corrélation ne satisfait plus les conditions qui assuraient à la LDA un certain sens physique.

Afin de corriger ces problèmes, la fonctionnelle ci-dessus a été modifiée pour la forcer à respecter les principales conditions aux limites. Nous obtenons alors l'approximation du gradient généralise (GGA ou *Generalized Gradient Approximation* en anglais) à l'origine du succès de la DFT :

$$E_{xc}^{GGA}[\rho; \nabla_{\rho}] = \int \varepsilon_{xc}^{GGA}(\rho(r), \nabla \rho(r)) dr \qquad (\text{II-29})$$

Souvent les contributions pour l'échange et la corrélation sont développées séparément

$$E_{xc}^{GGA}[\rho;\nabla_{\rho}(\mathbf{r})] = (\rho,\nabla_{\rho}) + \varepsilon_{xc}^{GGA}(\rho,\nabla_{\rho})$$
(II-30)

Le problème majeur de la LDA provenant de l'échange, une attention toute particulière fut portée sur le développement de cette partie

$$\varepsilon_x^{GGA}[\rho, \nabla_{\rho}] = \varepsilon_x^{LDA} - \int F(s(r)) \rho^{3/4}(r) dr \qquad (\text{II-31})$$

$$\mathbf{s}(r) = \frac{|\nabla_{\rho}(r)|}{\rho^{3/4}(r)} \tag{II-32}$$

En revanche, il existe plusieurs façons d'inclure le gradient de la densité [22, 23]. Dans ce travail, on a systématiquement préféré la formulation de *Perdew*, *Burke* et *Ernzerhof* (*PBE*) [24] de la construction qui est transparente et libre de paramètres.

II. 2. 4. 4. Résolution des équations de Kohn-Sham

La résolution des équations de Kohn-Sham (II -24) nécessite le choix d'une base pour les fonctions d'onde que l'on peut prendre comme une combinaison linéaire d'orbitales appelées orbitales de Kohn-Sham écrites sous fourme:

$$\Psi_j(\vec{r}) = \sum C_{j\alpha \, \varphi_\alpha} \tag{II-33}$$

où: $\varphi \alpha r$ sont les fonctions de base et les $Cj\alpha$ sont les facteurs de l'expansion. Puisque l'énergie totale est variationnelle dans la DFT, la solution auto-cohérente des équations de *KS* revient à déterminer les $Cj\alpha$ pour les orbitales occupées qui minimisent l'énergie totale. La résolution des équations de *KS* pour les points de symétrie dans la première zone de *Brillouin* permet de simplifier les calculs. Cette résolution se fait d'une manière itérative en utilisant un cycle d'itération auto-cohérent illustré par l'organigramme de la figure (II.2). On commence par injecter la densité de charge initiale ρ_{in} pour diagonaliser l'équation séculaire:

$$(H - \varepsilon_j S)C_j = 0 \tag{II-34}$$

avec : H représente la matrice hamiltonienne et S la matrice de recouvrement.

Ensuite, la nouvelle densité de charge ρ_{out} est construite avec les vecteurs propres de cette équation séculaire en utilisant la densité de charge totale qui peut être obtenue par une sommation sur toutes les orbitales occupées. Si les calculs ne concordent pas, on mélange les deux densités ρ_{in} et ρ_{out} de la manière suivante:

$$\rho_{in}^{j+1} = (1-\alpha)\rho_{out}^j \tag{II-35}$$

j représente la j^{eme} itération et α un paramètre de mixage. Ainsi la procédure itérative peut être poursuivie jusqu'à ce que la convergence soit réalisée. On peut présenter ce cycle par le schéma ci-après:



Figure II-2 Organigramme d'un calcul auto-cohérent dans une méthode basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité électronique.

Références

[1] E. Schrödinger, Ann.phys,**79**, 489, (1926); E.Schrondinger, Ann.Phys.,**79**, 361,(1926).

[2] M. Born, R. Oppenheimer, Ann. Physik., 84, 457, (1927).

[3] D. R. Hartree, Proc. Combridge Philos. Soc. 24, 89, (1928).

[4] V. Fock, Z. Phys. 61, 126(1930).

[5] L. H. Thomas, The calculation of atomic fields, Proc. Cambridge Phil. Soc., 23, 542, (1927).

[6] E. Fermi, Un metodo satatistico per la determinazione di alcune priorieta dell'atome, Rend. Accad. Naz. Lincei, 6, (1927) 602.

[7] R. G. Parr and W. Yang, Density-Functional Theory of Atoms and Molecules (Oxford Science Publication), (1989).

[8] P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. 136, B864, (1964).

[9] W. Kohn, L. Sham, Phys. Rev, A1133, 140, (1965).

[10] R. M. Dreizler and J. da Provincia, Density Functional Methods in Physics, (Plenum, NewYork), (1985).

[11] A. D. Becke, Phys. Rev. A 38, 3098, (1988).

[12] J. P. Perdew, J. A. Chevary, S. H. Vosko, K. A. Jackson, M. R. Peederson, D. J. Singh and C. Fiolhais, Phys. Rev. B 46, 6671, (1992).

[13] P. A. M. Dirac, Proc. Cam. Phil. Soc. 23, 542, (1927).

[14] D. M. Ceperley and B. J. Alder, Phys. Rev. Lett. 45, 566, (1980).

[15] L. Hedin and B. I. Lundqvist, Explicit local exchange- correlation potential, J. Phys. C 4, 2064, (1971).

[16] J. P. Perdew and Wang, Accurate and simple analytic representation of the electronxwsgaz correlation energy, Phys. Rev. B 45, 13244, (1992).

[17] A. Zunger and A. J.freeman, Phys. Rev. B 16, 2901, (1977).

[18] A. Zunger and A. J.freeman, Phys. Rev. B 16, 4716, (1977).

[19] V. L. Moruzzi, J. F. Janak, and A. R. William, Calculated Electronic Properties of Metal, Pergamon, New York (1978).

[20] J. C. Slater, Phys. Rev. 81, 385, (1951).

[21] C. Fiolhais, F. Nogeria and M. Marque. A premire in Densty Fonctinnele Théorei. Spring, (2003).

- [22] J. P. Perdew, Phys. Rev. Lett. 55, 1665–1668 (1985).
- [23] J. P. Perdew, Physica B 1, 172 (1991).
- [24] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).



Method des Ondes Planes Augmentées Linéairisées

III. 1. Introduction

Il existe plusieurs méthodes de calcul des structures de bandes, qui sont classées en trois principaux types, ce qui nécessite des résultats expérimentaux ou des données fondamentales :

- Les méthodes empiriques pour lesquelles les calculs nécessitent des résultats expérimentaux.
- Les méthodes semi-empiriques pour lesquelles les calculs nécessitant à la fois des résultats expérimentaux et des données fondamentales.
- Les méthodes *ab-initio* pour lesquelles les calculs nécessitent seulement les données fondamentales.

Ces dernières années, les chercheurs ont développé des méthodes basées sur des concepts théoriques appelées les méthodes de premier principe, parmi lesquelles on peut citer trois groupes de méthodes pour la résolution de l'équation de *Schrödinger* et basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) :

- Les méthodes basées sur une combinaison linéaire d'orbitales atomiques (LCAO) [1,2], utilisables, par exemple, pour les bandes d des métaux de transition.
- Les méthodes dérivées des ondes planes orthogonalités (OPW) [2, 3] mieux adaptées aux bandes de conduction de caractère *s-p* des métaux simples.
- Les méthodes cellulaires du type ondes planes augmentées (APW) [4] et la méthode de la fonction de *Green* de *Korringa*, *Kohn* et *Rostoker* (KKR) [5, 6] applicables à une plus grande variété de matériaux.
- Les méthodes linéarisées mises au point par Andersen [7]: Ondes planes augmentées linéarisées (LAPW) et orbitales Muffin-Tin linéarisées (LMTO), permettent de gagner plusieurs ordres de grandeur dans les temps de calcul.

III. 2. La méthode des ondes planes linéairement augmentées (FP-LAPW)

La méthode des ondes planes augmentées et linéarisées (LAPW) (Linearized Augmented Plane Waves) [8,9], développée par Andersen [10], est fondamentalement

une amélioration de la méthode des ondes planes augmentées(APW) élaborée par Slater [11, 4]. Rappelons en premier lieu les bases de la méthode APW.

III.2.1. Méthode des ondes planes augmentées (APW)

En 1937, *Slater* [4] a présenté la méthode des ondes planes augmentées qui se base sur l'idée principale suivante : « le potentiel et les fonctions d'ondes sont similaires à ceux d'un Atome isolé ». D'où on peut tirer les deux conclusions suivantes:

- Le potentiel et les fonctions d'ondes présentent une symétrie sphérique et varient fortement au voisinage du noyau.
- Entre les atomes, c'est-à-dire loin du noyau, le potentiel et les fonctionsd'ondes peuvent être considérés comme étant lisses (approximation muffin-tin).

En conséquence, l'espace est divisé en deux régions distinctes: des sphères centrées sur les sites atomiques de rayons *RMT* et une région interstitielle (Figure III.1). De ce fait, les fonctions d'ondes du cristal sont développées dans des bases différentes selon la région considérée : des solutions radiales de l'équation de Schrödinger dans la sphère de rayon *RMT* et des ondes planes dans la région interstitielle.



Figure III.1. Division de la maille élémentaire en sphères atomiques et régions interstitielles.

D'après l'approximation *muffin-tin*, la fonction d'onde $\varphi(r)$ est de la forme

$$\{\boldsymbol{\varphi}(r) = \sum_{lm} A_{lm} \ U_{lm}(r) Y_{lm}(r) \text{ à l'intérieur de la sphère RMT}$$
(III-1)

$$\{\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{G} C_{G} e^{i(K+G)r}$$
 hors de la sphère RMT (III-2)

où Ω est le volume de la maille élémentaire, A_{lm} et C_G sont des coefficients de développement, $Y_{l,m}(r)$ sont les harmoniques sphériques et $U_l(r)$ la solution régulière de l'équation de *Schrödinger* pour la partie radiale qui est donnée par

$$\left\{\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + V(r) + E_l\right\} r U_l(r) = 0$$
(III-3)

V(r) est la composante sphérique du potentiel dans la sphère (potentiel *Muffin-Tin*) et E_L est l'énergie de linéarisation. Les fonctions radiales définies par cette équation sont orthogonales à tout état propre du cœur de la sphère. L'orthogonalité de ces fonctions disparait à la limite de la sphère [11] comme c'est montré dans l'équation de *Schrödinger* suivante :

$$(E_{2}-E_{1})rU_{1}U_{2} = U_{2}\frac{d^{2}rU_{1}}{dr^{2}} - U_{1}\frac{d^{2}rU_{2}}{dr^{2}}$$
(III-4)

telles que U_1 et U_2 des solutions radiales pour les énergies E_1 et E_2 . Le recouvrement est construit par intégration par parties de cette équation.

Slater considère que les ondes planes sont des solutions de l'équation de *Schrödinger* lorsque le potentiel est constant, c'est-à-dire dans la région interstitielle, tandis que les fonctions radiales sont des solutions dans le cas d'un potentiel sphérique lorsque E_L est une valeur propre. Cette approximation est très satisfaisante pour les matériaux à structure cubique à faces centrées, mais non applicable pour les matériaux asymétriques.

Pour assurer la continuité de la fonction $\varphi(r)$ à la surface de la sphère *MT*, les coefficients A_{lm} doivent être développés en fonction des coefficients C_G des ondes planes de la région interstitielle. Ces coefficients sont ainsi exprimés de la façon suivante :

$$A_{lm} = \frac{4\pi l \, i^l}{\sqrt{\Omega} U_1(R_{MT})} \sum_G C_G(|K+G|R_{MT}) \, Y_{lm}^* \left(\vec{K} + \vec{G}\right) \tag{III-5}$$

L'origine est prise au centre de la sphère de rayon *RMT*, et ainsi les coefficients sont exprimés en fonction des coefficients des ondes planes C_G . Les paramètres d'énergie E_l sont appelés les coefficients variation els de la méthode *APW*. Les fonctions d'indice *G* deviennent ainsi compatibles aux fonctions radiales dans les sphères, et on obtient donc des ondes planes augmentées *APW*. Les fonctions *APW* sont des solutions de l'équation de Schrödinger pour les énergies E_l seulement. En conséquence, l'énergie E_l doit être égale à celle de la bande d'indice *G*, ce qui signifie que les bandes d'énergie (pour un point *k*) ne peuvent pas être obtenues par une simple diagonalisation et qu'il est nécessaire de traiter le déterminant séculaire comme une fonction de l'énergie.

Le problème de la méthode APW est qu'on trouve dans le dénominateur de la fonction $U_l(RMT)$, le paramètre E_l qui peut prendre la valeur zéro à la surface de la sphère MT, entrainant ainsi une séparation entre les fonctions radiales et les fonctions d'onde plane. Pour résoudre ce problème, plusieurs modifications ont été apportées à la méthode APW, les plus répandues sont celles de *Koelling* [12] et *Andersen* [7].

La modification d'Andersen consiste à représenter les fonctions d'ondes à l'intérieur des sphères par une combinaison linéaire des fonctions radiales $U_l(r)$ et de leurs dérivées par rapport à l'énergie E_l soit $\dot{U}_l(r) = \frac{dU_l}{dE_l}$, donnant ainsi naissance à la méthode *LAPW*.

III. 2. 2. Méthode des ondes planes augmentées linéarisées (LAPW)

La méthode LAPW (L*inearized Augmented Plane Waves*), développée par Andersen [13,14], est une amélioration de la méthode des ondes planes augmentées (APW) dans laquelle les fonctions de base et leurs dérivées sont continues par adaptation à la fonction radiale et sa dérivée. En citant quelques privilégies de la méthode LAPW par rapport à la méthode APW, on note :

Dans la méthode LAPW, les énergies des bandes au point k sont obtenues avec une seule diagonalisation ce qui réduit le temps de calcul. Alors que dans la méthode APW, il est nécessaire de calculer l'énergie pour chaque bande. La convergence est devenue plus rapide dans LAPW en comparaison avec la méthode APW .

III. 3. Les roles des énergies de linéarisation (E₁)

Les fonctions U_L et U'_L sont orthogonales à n'importe quel état de cœur strictement limité à la sphère MT. Mais cette condition n'est satisfaite que dans le cas où il n'y a pas d'états de cœur avec la même valeur de *l*, et par conséquent, on prend le risque de confondre les états de semi-cœur avec les états de valence. Ce problème n'est pas traité par la méthode APW, alors que la non-orthogonalité de quelques états de cœur dans la méthode FP-LAPW exige un choix délicat de E_l . Dans ce cas, on ne peut pas effectuer le calcul sans modifier E_l .

La solution idéale dans tels cas est d'utiliser un développement en orbitales locales. Cependant, cette option n'est pas disponible dans tous les programmes et dans ce cas, on doit choisir un rayon de la sphère le plus grand possible.

Finalement, il faut remarquer que les diverses E_l devraient être définies indépendamment les unes des autres. Les bandes d'énergie ont des orbitales différentes. Pour un calcul précis de la structure électronique, E_l doit être choisie le plus proche possible de l'énergie de la bande si la bande a le même *l*.

III.4 Développement en orbitales locales

Le but de la méthode LAPW est d'obtenir des énergies de bande précises au voisinage des énergies de linéarisation E_l [7]. Pour la plupart des matériaux, il suffit de choisir ces énergies au voisinage du centre des bandes. Ce qui n'est pas toujours possible car il existe des matériaux pour lesquels le choix d'une seule valeur de Eln'est pas suffisant pour calculer toutes les bandes d'énergie, c'est le cas pour les matériaux ayant des orbitales 4f [15, 16] et les métaux de transition [17, 18]. C'est le problème fondamental de l'état de semi-cœur qui est intermédiaire entre l'état de valence et celui de cœur. Pour pouvoir résoudre ce problème, on a recours soit à l'usage des fenêtres d'énergies multiples, soit à l'utilisation d'un développement en orbitales locales.

III. 4. 1.Méthode LAPW+LO

Le développement de la méthode *LAPW* en orbitales locales consiste à modifier les orbitales de sa base pour éviter l'utilisation de plusieurs fenêtres. Le principe est de traiter l'ensemble des bandes à partir d'une seule fenêtre d'énergie. *Singh* a donné ces orbitales, notées $\ll LO \gg$ sous forme d'une combinaison linéaire de deux fonctions radiales correspondant à deux énergies différentes et de la dérivée par rapport à l'énergie de l'une de ces fonctions [19] :

$$\varphi(r) \begin{cases} 0 & r > R_{MT} \\ \left[A_{lm}U_{lm}(r, E_{l,1})B_{lm}U^{*}_{l}(r, E_{l,1}) + C_{lm}U_{l}(r, E_{l,2})\right]Y_{lm}(r) & r < R_{MT} \\ (\text{III-6}) \end{cases}$$

où les coefficients C_{lm} sont de la même nature que les coefficients A_{lm} et B_{lm} définis précédemment. Par ailleurs, cette modification diminue l'erreur commise dans le calcul des bandes de conduction et de valence.

III.4.2.Méthode APW+LO

Le problème rencontré dans la méthode APW était la dépendance en énergie de l'ensemble des fonctions de base. Cette dépendance a pu être éliminée dans la méthode *LAPW+LO* mais au prix d'une base de taille plus importante, et de ce fait les méthodes *APW* et *LAPW+LO* acquièrent toutes deux une limitation importante.

Sjösteds, Nordström et Singh [20] ont apporté une amélioration en réalisant une base qui combine les avantages de la méthode APW et ceux de la méthode LAPW+LO. Cette méthode est appelée: APW+Lo et correspond à une base indépendante de l'énergie et qui ne requiert qu'une énergie de coupure d'ondes planes très faiblement supérieure à celle nécessaire dans le cadre de la méthode APW. Elle consiste à utiliser une base APW standard mais en considérant $U_l(r)$ pour une énergie E_l fixée de manière à conserver l'avantage apporté par la linéarisation du problème aux valeurs propres. Mais du fait qu'une base d'énergies fixes ne fournit pas une description satisfaisante des fonctions propres, on y ajoute également des orbitales locales qui permettent d'assurer une flexibilité vibrationnelle au niveau des fonctions de base radiales.

Une base APW+Lo est définie par l'association des deux types de fonctions d'onde suivants :

- Des orbitales locales, mais d'un type différent de celui de la méthode LAPW+LO

- Des orbitales locales, mais d'un type différent de celui de la méthode LAPW+LO

Dans un calcul, une base mixte LAPW et APW+Lo peut être employée pour des atomes différents et même pour des valeurs différentes du nombre l. En général, on décrit les orbitales qui convergent plus lentement avec le nombre des ondes planes (comme les états 3d des métaux de transition), ou bien les atomes ayant une petite taille de sphère avec la base APW+Lo et le reste avec une base LAPW [21].

III. 5. Le concept de la méthode FP-LAPW

Dans la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total FP-LAPW[22], aucune approximation n'est faite pour la forme du potentiel ni de la densité de charge. Ils sont plutôt développés en des harmoniques du réseau à l'intérieur de chaque sphère atomique, et en des séries de Fourrier dans les régions interstitielles. Cette méthode assure donc la continuité du potentiel à la surface de la sphère *MT* et le développe :

$$V(r) = \begin{cases} \sum_{K} V_{K} e^{iK r} & r > R_{\alpha} \\ \sum_{lm} V_{lm} Y_{lm} (r) & r < R_{\alpha} \end{cases}$$
(III-9)

De la même manière, la densité de charge est développée sous la forme:

$$\rho(r) = \begin{cases} \sum_{K} V_{\rho k} e^{ikr} & r > R_{\alpha} \\ \sum_{lm} \rho_{lm Y_{lm}}(r) & r < R_{\alpha} \end{cases} \tag{III-10}$$

III. 6. Le code Wien2k

La méthode des ondes planes linéairement augmentées (LAPW) s'est avérée être une des méthodes les plus précises pour le calcul de la structure électronique des solides dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de densité. La méthode des ondes planes linéairement augmentées avec un potentiel complet généré automatiquement (FP-LAPW) pour les solides cristallins a été développée pendant plus de vingt ans. Une première version, appelée W*ien*, a été éditée par P. Blaha et *al.* [15]. Des versions mises à jour les années suivantes et sensiblement améliorées ont été développées par la suite (WIEN93, WIEN95 et WIEN97). Une version ultérieure, WIEN2k, est disponible. Elle est basée sur un ensemble de base alternatif qui permet une amélioration significative, particulièrement en termes de vitesse, d'universalité et de facilite d'emploi.

III. 6.1.Wien2k

Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode FP-LAPW, implémentée dans le code Wien2k [16]. Le code Wien2k consiste en différents programmes indépendants (figure III-3) qui sont liés par C. Shell Script :

NN : C'est un programme qui donne les distances entre plus proches voisins, qui aide a déterminer le rayon atomique de la sphère.

LSTART : Un programme qui génère les densités atomiques et détermine comment les différentes orbitales sont traitées dans le calcul de la structure de bande, comme des états du coeur avec ou sans orbitales locales.

SYMMETRY : Il génère les opérations de symétrie du groupe spatial, détermine le groupe ponctuel des sites atomiques individuels, génère l'expansion LM pour les harmoniques du réseau et détermine les matrices de rotation locale.

KGEN : Il génère une maille k dans la zone de Brouillin

DSTART : Il génère une densité de départ pour le cycle SCF par la superposition des densités atomiques générées dans LSTART.

Alors un cycle self consistant est initialisé et répété jusqu'à ce que le critère de convergence soit vérifie. Ce cycle s'inscrit dans les étapes suivantes :

LAPW0 : Génère le potentiel pour la densité

LAPW1 : Calcule les bandes de valence, les valeurs propres et les vecteurs propres.

LAPW2 : Calcule les densités de valence pour les vecteurs propres.

LCORE : Calcule les états du coeur et les densités.

MIXER : Mélange les densités d'entre et de sortie.



Figure III-2 L'organigramme du programme de wien2k.

III.7. Conclusion

La méthode FP-LAPW fournit une base plus facile et plus précise que celle de la méthode APW et comparativement à d'autres méthodes théoriques. Finalement, nous avons brièvement exposé le code de calcul WIEN2k avec le fonctionnement de ses sous-programmes où l'ensemble de ces packages est un outil d'exploitation fondamental de la méthode FP-LAPW.

Références

- [1] F. Bloch, Z. Phys. 52, 555 (1928).
- [2] J. C. Slater, « Quantum Theory of Molecules and Solids », 2, 8 (1965).
- [3] C. Herring, Phys. Rev. 57, 1169 (1940).
- [4] J. C. Slater, Phys. Rev. 51, 846 (1937).
- [5] J. Korringa, Physica, 13, 392 (1947).
- [6] F. S. Ham and B. Segall, Phys. Rev, 124, 1786 (1961).
- [7] O. K. Andersen, Phys. Rev. B 12, 3060 (1975).
- [8] N. Troullier and J. L. Martins, Phys. Rev. B 43 (1991) 1993.
- [9] G. Kresse, J. Hafner and R. J. Needs, J. Phys. Condens. Matter 4 (1992) 7451.
- [10] R. El Ouenzerfi, S. Ono, A. Quema, M. Goto, N. Sarukura, T. Nishimatsu,

N.Terakubo, J.Appl. Phy.96 (2004) 7655.

[11] J.C. Slater, Advences in Quantum Chemistry 1 (1964)35..

[12] D. D. Koelling and G. O. Arbman, J. Phys. F 5, (1975) 2041

[13] H. ABBASSA, « *Contribution à l'étude des propriétés physico-chimiques des alliages d'Heusler »*, Université de Mostaganem, Thèse (2015).

[14] T. Ouahrani, « *Calcul des propriétés structurales, thermiques et optiques des composés chalcopyrites par la méthode FP-(L)APW* », Université de Tlemcen, Thèse (2011).

[15] Singh, D., Phys. Rev. B 44, 7451 (1991).

[16] S. Goedecker and K. Maschke, Phys. Rev. B 42, 8858 (1990).

[17] Singh, D. and H. Krakauer, *H-point phonon in molybdenum: Super linearized augmented plane wave calculations.* Physical Review B, 1991. **43**(2): p. 1441.

[18] Blaha, P., et al., *Electric-field-gradient calculations for systems with large extended-core-state contributions*. Physical Review B, 1992. **46**(3): p. 1321.

[19] A. Boumaza. Etude *ab-initio* des propriétés structurales, électroniques et thermique des ternaires et quaternaires. Thèse de doctorat en physique. Université Badji Mokhtar (2014).

[20] D.J. Singh, Phys. Rev. B 43 (1991) 6388.

[21] G.H.K. Madsen, P. Blaha, K. Schwarz, E. Sjösted and L. Nordström, Phys. Rev. B. 64(2001)195134. [22] D. R Hamann, Phys. Rev. Lett. 212, 662 (1979).

[23] P.Blaha, K.Schwarz, P.Sorantin, and S.B.Trickey, in Comput. Phys. Commun.59,339(1990)



Résultats et discussions

IV-I Introduction

En général, les alliages Heusler cristallisent dans des structures cubiques du réseau de Bravais cubique à faces centrées. Les alliages dits Full Heusler ont une composition stœchiométrique de type X_2YZ , où X et Y sont des métaux de transition et Z représente les éléments non magnétiques du groupe III, IV ou V dans le tableau périodique. Ils cristallisent soit dans la structure régulière $L2_1$ (Fm-3m, groupe spatial n° 225) avec Cu₂MnAl comme prototype, soit dans la structure inverse Heusler (groupe spatial F-43m n° 216) avec CuHg₂Ti comme prototype.

Dans la structure $L2_1$, les atomes X occupent les sites A (0, 0, 0) et C (1/2, 1/2, 1/2), l'atome Y occupe le site B (1/4, 1/4, 1/4) et l'atome de Z occupe le site D (3/4, 3/4, 3/4) comme le montre la figure IV-1. Dans la structure inverse, les atomes X(1) (ou X(A)) et X(2) (ou X(B)) occupent les sites non-équivalents A (0, 0,0) et B (1/4,1/4,1/4), respectivement, tandis que les atomes Y et Z sont localisés sur les sites C (1/2,1/2,1/2) et D (3/4,3/4,3/4), respectivement.



Figure IV-1 Représentation schématique de la structure $L2_1$ pour les alliages Full Heusler de type X_2YZ

Il existe une classe intéressante des alliages Heusler qui ne contenant pas des métaux de transition et qui présentent le comportement demi métallique [1-7].

Récemment, des études théoriques ont montré que ces alliages peuvent avoir de hautes températures de Curie et de faibles moments magnétiques. Ceci donne un avantage

primordial dans les applications et motive la recherche de nouveaux matériaux demimétalliques qui peuvent être de bon candidats pour la spintronique.

Notre objectif dans le présent travail est d'étudier les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de l'alliage Full-Heusler RbMgO₂ par un calcul *ab-initio* basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité.

IV-2 Les détails de calcul

Dans ce travail, nous avons calculé les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de l'alliage RbMgO₂. Les résultats des calculs donnés dans cette partie sont obtenus par le code WIEN2k [8] basé sur la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT) [9,10]. Ce code est une implémentation de la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) [11]. L'énergie d'échange et de corrélation est décrite par l'approximation du gradient généralisé GGA PBEsol (2008) [12].

Les fonctions de base, les densités électroniques et les potentiels sont développés sous forme de combinaison d'harmoniques sphériques centrées autour des sites atomiques avec un cut-off égal à $I_{max} = 10$ et en séries de Fourier dans la région interstitielle. Nous avons pris le paramètre R_{MT} . K_{max} qui contrôle la taille des bases égale à 8 (où R_{MT} est le plus petit rayon de la sphère MT et K_{max} est le cut-off du vecteur d'onde pour les ondes planes). Dans ces calculs, nous avons utilisé les rayons R_{MT} , donnés en unités atomiques (u.a ou Bohr), regroupés dans le tableau IV-I. La valeur de G_{max} est 12, dont G_{max} est la norme du plus grand vecteur d'onde utilisé pour le développement en ondes de la densité de charges. L'énergie de séparation entre les états de valence et du cœur est prise égale à -6.0 Ry. L'intégration K sur la zone de Brillouin a été effectuée, en utilisant le schéma de Monkhorst et Pack [13] avec 3000 points. Nous avons effectué des calculs SCF (champ self consistent) avec test de convergence tel que le procédé itératif est répété jusqu'à ce que l'erreur sur la densité de charge soit inférieure à 10^{-5} .

Tableau IV-1 Rayons muffin-tin R_{MT} des éléments constituant le composé RbMgO₂.

Atome	Rb	Mg	0
R_{MT} (u.a ou Bohr)	2	2	2

IV-3 Propriétés structurales

L'alliage full Heusler X₂YZ comporte deux structures: la structure AlCu₂Mn ou $L2_1$ de groupe d'espace n° 225 et la structure CuHg₂Ti ou inverse de groupe d'espace n° 216. Pour notre alliage RbMgO₂ et dans la structure $L2_1$, les atomes O occupent les sites A (0, 0, 0) et C (1/2, 1/2, 1/2), l'atome Rb occupe le site B (1/4, 1/4, 1/4) et l'atome de Mg occupe le site D (3/4, 3/4, 3/4). Dans la structure inverse, les atomes O(1) et O(2) occupent les sites non-équivalents A (0, 0, 0) et B (1/4, 1/4, 1/4), respectivement tandis que les atomes Rb et Mg sont localisés sur les sites C (1/2, 1/2, 1/2) et D (3/4, 3/4, 3/4), respectivement.

Nos calculs sont effectués par des optimisations structurales en minimisant l'énergie totale en fonction du volume V dans les deux structures de types AlCu₂Mn et CuHg₂Ti de l'alliage Full Heusler RbMgO₂. Les figures IV-2 et IV-3 montrent les énergies totales pour les deux configurations ferrimagnétiques (FM) et non magnétiques (NM) en fonction du volume pour l'alliage RbMgO₂ dans les deux structures. On déduit que l'état FM est le plus stable puisqu'il présente une énergie plus basse dans les deux structures. On constate aussi que la différence d'énergie ΔE entre les états (NM) et les états (FM) augmente en fonction du volume dans les deux structures de types AlCu₂Mn et CuHg₂Ti, ce qui signifie que la configuration ferromagnétique se stabilise aux larges volumes.

Pour déterminer la structure d'équilibre, nous avons tracé les énergies totales en fonction du volume pour les deux types de structure à l'état FM comme le montre la figure IV-4. On trouve que pour le composé RbMgO₂, l'énergie d'équilibre du type CuHg₂Ti est supérieure à celle du type AlCu₂Mn, ce qui indique que cette dernière structure est énergiquement plus stable. Ainsi, la structure de type AlCu₂Mn est plus favorable que la structure de type CuHg₂Ti pour le composé RbMgO₂.



Figure IV-2 Energie totale calculée en fonction du volume pour l'alliage $RbMgO_2$ dans la structure AlCu₂Mn (225) pour les états non magnétique (NM) et ferromagnétique (FM).



Figure IV-3 Energie totale calculée en fonction du volume pour l'alliage $RbMgO_2$ dans la structure CuHg₂Ti (216) pour les états non magnétique (NM) et ferromagnétique (FM).



Figure IV-4 Energie totale calculée en fonction du volume pour l'alliage $RbMgO_2$ dans les deux structures $AlCu_2Mn$ et $CuHg_2Ti$ pour l'état ferromagnétique (FM).

Pour déterminer les paramètres structuraux de l'alliage Full Heusler RbMgO₂ pour les deux structures de types AlCu₂Mn et CuHg₂Ti, nous avons effectué un calcul self-consistent de l'énergie totale en fonction du volume. Le paramètre de maille du réseau à l'équilibre a (Å), le module de compressibilité B_0 (GPa) et sa dérivée par rapport à la pression B'_0 sont déterminés après ajustement de l'énergie totale E en fonction du volume V à l'équation d'état de Birche-Murnaghan [14] donnée par:

$$E(V) = E_0 + \frac{9B_0V}{16} \left\{ \left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right]^3 \dot{B}_0 + \left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right]^2 \left[6 - 4 \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} \right] \right\}$$
(IV-1)

où:

E: l'énergie totale, E_0 l'énergie de l'état fondamental, B_0 le module de compression. B'_0 : La dérivée première du module de compression par rapport à la pression, V: le volume de la maille élémentaire et V_0 : le volume initial de la maille.

Le module de compressibilité B_0 et sa dérivée sont déterminés par :

$$B = V \left(\frac{d^2 E}{dV^2}\right)_{V=V_0}$$
(IV.2)

$$B'_{0} = \left(\frac{\partial B}{\partial P}\right)_{P=0}$$
(IV.3)

La constante du réseau à l'équilibre est donnée par le minimum de la courbe E(V)

$$V = V_0 \left[1 + \frac{B'P}{B_0} \right]^{1/B'}$$
(IV.4)

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau IV-2 avec les résultats théoriques disponibles. On note que le paramètre de maille d'équilibre calculé est en bon accord avec celui trouvé par un calcul théorique précédent [15] dans la structure AlCu₂Mn pour la phase FM de l'alliage RbMgO₂. A partir du tableau IV-2, on remarque que notre paramètre de maille est légèrement supérieur à celui donné par la référence [15]. Cette différence entre les deux valeurs est due aux approximations utilisées sachant que la GGA surestime le paramètre de maille par rapport au LSDA dont les auteurs de la référence [15] ont utilisé la méthode TB-LMTO avec l'approximation LSDA.

On remarque aussi que les modules de compression B dans la structure AlCu₂Mn sont supérieurs à ceux de la structure CuHg₂Ti.

L'énergie de cohésion des solides est également calculée afin d'étudier la stabilité physique de la phase. C'est une mesure de la force qui lie l'ensemble des atomes à l'état solide. L'énergie de cohésion dans une phase donnée est définie comme la différence entre l'énergie totale de la phase particulière et la somme des énergies atomiques totales des atomes constituants le cristal.

$$E_{coh} (\text{RbMgO}_2) = E_{tot} (RbMgO_2) - [2E_{tot} (O) + E_{tot} (Rb) + E_{tot} (Mg)] (\text{IV-5})$$

où E_{tot} ($RbMgO_2$) est l'énergie totale de l'alliage. $E_{tot}(O)$, $E_{tot}(Rb)$ et $E_{tot}(Mg)$ sont les énergies totales des constituants élémentaires purs. Les valeurs de l'énergie de cohésion E_{coh} sont regroupées aussi dans le tableau IV-2. Nous pouvons constater aussi que les valeurs de l'énergie de cohésion sont négatives, pour le composé étudié, ce qui signifie l'existence et la stabilité physique de cet alliage dans les deux types de structure. On remarque que l'énergie de cohésion dans la structure CuHg₂Ti est inférieure, en valeur absolue, à celle de la structure AlCu₂Mn puisque cette dernière est l'état fondamental de l'alliage RbMgO₂ où il est énergétiquement plus stable.

Type de	a(Å)	$V_0(u.a)^3$	$E_0(Ry)$	B(GPa)	B'	$E_{coh}(eV)$
structure						
AlCu ₂ Mn	6.0481	373.2479	-6659.061677	74.17	4.4329	-12,86
(FM)	6.018 [15]			70 [15]		$-16.81^{[15]}$
AlCu ₂ Mn	6.0399	371.7350	-6659.051510	74.14	4.3134	-12,73
(NM)						
CuHg ₂ Ti	6.0385	371.4659	-6658.847372	65.44	4.8424	-9,95
(FM)						
CuHg ₂ Ti	6.0259	369.1452	-6658.835907	67.01	4.8075	-9,79
(NM)						

Tableau IV-2 Les paramètres de maille d'équilibre *a*, les volumes V_0 , les valeurs d'énergie d'équilibre E_0 , le module de compression *B*, sa dérivée *B*' et l'énergie de cohésion E_{coh} des deux structures AlCu₂Mn et CuHg₂Ti dans les phases FM et NM de l'alliage RbMgO₂

IV-4 Propriétés électroniques

IV-4-1 Structures de bandes

On a calculé les structures de bandes polarisées en spin du composé RbMgO₂ dans la structure régulière, au paramètre de maille d'équilibre le long des directions de haute symétrie dans la zone de Brillouin (ZB). On présente, dans les figures IV-5 (a, b), ces structures de bandes polarisées en spin.

Selon la figure IV-5-a, on constate l'existence d'une bande d'énergie interdite importante telle que le maximum de la bande de valence se trouve au point X et le minimum de la bande de conduction se coïncide avec le point Γ , ce qui signifie qu'il existe un gap indirect G_{Maj} d'une valeur considérable de 2.961 eV dans la direction des spins majoritaires autour du niveau de Fermi.

D'autre part et d'après la Figure IV-5-b, nous constatons des intersections entre les bandes de valence et le niveau de Fermi pour les spins minoritaires, ce qui indique un comportement métallique. Par conséquent, le composé $RbMgO_2$ est un semiconducteur pour les spins majoritaires alors qu'il est métallique pour les spins minoritaires. Ceci confirme le caractère demi-métallique à l'état d'équilibre qui amène à une polarisation de spin de 100% au niveau E_F . Alors, le composé $RbMgO_2$ est un vrai demi-métal ferromagnétique à l'équilibre. On note que le gap G_{Maj} est légèrement inférieur à celui de la référence [15]. Cette différence est attribuée au fait que les auteurs de la référence [15] ont utilisé la méthode TB-LMTO avec l'approximation LSDA tout en sachant que la GGA souestime les valeurs des gaps.

La valeur du gap demi-métallique G_{HM} , qui correspond à l'énergie minimale requise pour faire basculer un électron de spin up du maximum de la bande de valence au niveau de Fermi avec un spin down, est de 0.495 eV. Elle est légèrement supérieure à celle citée dans la référence [15]. Les valeurs des gaps G_{Maj} et G_{HM} sont rapportées dans le tableau IV-3.

	Energie du	$a \operatorname{gap} G_{M_{aj}}(eV)$	Energie du gap HM $G_{HM}(eV)$		
Le					
composé	Notre calcul	Autre calcul	Notre calcul	Autre calcul	
	(GGA PBEsol)	(LSDA)	(GGA PBEsol)	(LSDA)	
RbMgO ₂					
	2.961	3.094 [15]	0.495	0.400 [15]	

Tableau IV-3 Les valeurs des gaps G_{Maj} (eV) et G_{HM} (eV) calculées au paramètre d'équilibre pour la bande des spins majoritaires de l'alliage RbMgO₂ dans la structure de type AlCu₂Mn.



Figure IV-5-a Structure de bandes calculées au paramètre d'équilibre de l'alliage RbMgO₂ pour des spins majoritaires dans la structure de type AlCu₂Mn.



Figure IV-6-b Structure de bandes calculées au paramètre d'équilibre de l'alliage RbMgO₂ spins minoritaires dans la structure de type AlCu₂Mn.

IV-4-2Densités d'états électroniques (DOS)

Pour mieux comprendre la nature de la structure des bandes et l'origine du magnétisme, on a aussi représenté les densités d'états électroniques totale et partielles polarisées en spin de l'alliage $RbMgO_2$ dans la structure $AlCu_2Mn$. La Figure IV-6 montre ces DOS calculées à l'équilibre. D'après cette figure, on remarque que le composé $RbMgO_2$ présente un gap énergétique situé exactement au niveau de Fermi dans les états de spins majoritaires. Alors qu'un caractère métallique est observé pour les états de spins minoritaires. Par conséquent, le composé $RbMgO_2$ est un vrai demimétal.



Figure IV-7 Densités des états totale et partielles des atomes O, Mg et Rb de l'alliage RbMgO₂ dans la structure de type $AlCu_2Mn$ à l'équilibre.

Les régions d'énergie autour de -8 eV sont identiques dans les deux chaînes de spin up et spin down, elles appartiennent principalement aux états p de l'atome Rb. La contribution essentielle dans la région énergétique autour du niveau de Fermi proviennent des états p de l'atome O. En effet, on peut également noter à partir des DOS partielles qu'il existe une différence entre les états de spins majoritaire et minoritaire de l'atome O autour du niveau de Fermi, ce qui signifie que le moment

magnétique, dans ce composé, provient principalement de ce décalage des états p de l'atome O. La région d'énergie autour de 5 eV est due aux états s de l'atome Mg et les états p de l'atome O qui sont presque identiques pour les deux directions de spin. L'intervalle d'énergie autour de 8 eV est attribuée aux états p de l'atome Mg. La gamme d'énergie au dessus de 12 eV se compose essentiellement des états d de l'atome Rb.

IV-5 Propriétés magnétiques

Le tableau IV-4 présente les valeurs des moments magnétiques total M_{tot} , atomiques et interstitiel de l'alliage Heusler RbMgO₂ dans la structure de type AlCu₂Mn calculés au paramètre de maille d'équilibre. On constate que le moment magnétique total est égal à 1.000 μ_B à l'équilibre, ce qui révèle le caractère demimétallique de l'alliage RbMgO₂. D'après le tableau IV-4, le moment magnétique total provient principalement de l'atome O. Cela est dû au décalage important entre les états de spins majoritaire et minoritaire de cet atome.

Le composé RbMgO ₂	M _{tot}	M _O	M_{Mg}	M _{Rb}	M _{inte}
La structure	0.999999	0 ,50318	0,01666	- 0 ,01705	- 0 ,00598
AlCu2Mn.	1.0 ^[15]	0,513 ^[15]	- 0,018 ^[15]	- 0,045 ^[15]	

Tableau IV-4 Les valeurs du moment magnétique total, des moments magnétiques partiels et interstitiel du composé RbMgO₂ dans la structure AlCu₂Mn calculées au paramètre de maille d'équilibre. Toutes les valeurs sont en magnéton de Bohr (μ_B).

De plus et comme le montre également le tableau IV-4, les atomes Rb et Mg ont une faible contribution au moment magnétique total. Mais, ces atomes ont un rôle important pour déterminer le caractère demi-métallique, les propriétés magnétiques et la largeur du gap d'énergie pour la chaîne des spins up de notre alliage Heusler.

On constate aussi que la région interstitielle porte un moment magnétique négligeable, ce qui ne contribue pas beaucoup au moment total.

On remarque aussi que les moments magnétiques partiels des atomes O et Mg sont alignés parallèlement. Par contre, le moment magnétique partiel de l'atome Rb est aligné antiparallèlement mais sa valeur reste faible. En conséquence, l'alliage RbMgO₂ est un composé demi-métallique ferromagnétique.

Pour qu'un composé soit un demi-métal, il faut que son moment magnétique total soit un entier. Le moment magnétique total calculé du composé Heusler RbMgO₂ a une valeur entière de 1.00 μ_B qui suit parfaitement la règle de Slater-Pauling. La relation appropriée selon cette règle est donnée par la formule:

 $M_{tot} = (16 - Z_{tot})$ où M_{tot} est le moment magnétique total par unité de formule et Z_{tot} est le nombre total d'électrons de valence dans la maille élémentaire.

Pour l'alliage Heusler RbMgO₂, le moment magnétique total est de 1 μ_B par unité de formule ce qui est en parfait accord avec la relation citée puisque Z_{tot} est 15: 12 des deux atomes O ($2s^22p^4$), 1 de l'atome Rb ($5s^1$) et 2 de l'atome Mg ($3s^2$).

IV-6 L'effet du paramètre de maille sur la demi-métallicité

Pour la synthèse technique et les exigences des processus expérimentaux de croissance, il est utile d'étudier l'effet de variation des constantes du réseau sur les propriétés du composé RbMgO₂.

Le tableau IV-5 regroupe les moments magnétiques totaux, atomiques et interstitiels calculés pour le composé $RbMgO_2$ correspondant aux différents paramètres de maille, pour lesquels le composé conserve toujours la nature demi-métallique. L'intervalle de demi-métallicité est compris entre a = 5.61 Å et a = 6.42 Å. En dehors de cet intervalle, le composé $RbMgO_2$ devient un ferromagnétique classique sans caractère demi-métallique.

a (Å)	M _{tot}	M ₀	M _{Mg}	M _{Rb}	M _{interst}
5,61	0.99998	0.47583	0.05254	-0.01202	0.00780
5,73	1.00003	0.48428	0.04010	-0.01384	0.00478
5,84	1.00002	0.49143	0.03033	-0.01470	0.00153
5,94	1.00002	0.49766	0.02264	-0.01590	-0.00204
6,04	0.99998	0.50328	0.01656	-0.01707	-0.00607
6,14	0.99997	0.50852	0.01175	-0.01824	-0.01058
6,24	0.99997	0.51354	0.00793	-0.01942	-0.01562
6,33	0.99997	0.51837	0.00495	-0.02062	-0.02109
6,42	0.99996	0.52316	0.00265	-0.02187	-0.02714

Tableau IV-5 Les moments magnétiques total, interstitiel et partiels des atomes O, Mg et Rb calculés, en unité μ_{B} , pour le composé RbMgO₂ dans la structure de type AlCu₂Mn en fonction du paramètre de maille.

La figure IV-7 présente les variations des moments magnétiques total, interstitiel et partiels des atomes O, Rb et Mg dans la structure régulière de type AlCu₂Mn en fonction du paramètre de maille de l'alliage Heusler RbMgO₂.



Figure IV-8 Les variations des moments magnétiques total, interstitiel et partiels des atomes O, Rb et Mg en fonction du paramètre de maille de l'alliage Heusler RbMgO₂ dans la structure de type AlCu₂Mn.

D'après le Tableau VI-5 et la Figure IV-7, la valeur du moment magnétique total reste inchangée dans l'intervalle de variation. Le moment magnétique total *Mtot* est préservé comme une valeur entière de 1.00 μB sur une gamme relativement large que ce soit par une compression ou par une dilatation de la maille élémentaire par rapport à celle d'équilibre jusqu'à ce que le paramètre de maille soit compressé à une valeur critique de 5.61 Å ou soit dilaté à une valeur critique de 6.42 Å. Alors, la demimétallicité du composé RbMgO₂ est conservée par une compression de 7.2 % et une expansion de 6.1 % du paramètre de maille par rapport à l'équilibre. Au même temps, l'énergie de Fermi se trouve au sein du gap d'énergie pour la chaîne des spins majoritaires. En dehors de cet intervalle, *Mtot* ne devient pas un entier, ce qui entraîne une perte de la demi-métallicité.

On peut aussi facilement voir que la plus grande contribution au moment magnétique total provient de l'atome O dont les valeurs de son moment magnétique augmentent légèrement en fonction du paramètre de maille.

Par ailleurs, les moments magnétiques des atomes de Mg et Rb sont peu sensibles aux constantes de réseau et diminuent (avec signe négatif pour l'atome Rb) légèrement le long de l'intervalle de variation. De plus, on note que les valeurs négligeables du moment interstitiel ont aussi un faible décroissement en fonction du paramètre de maille.

En conséquence, le changement des moments magnétiques de O, Mg, Rb et le moment interstitiel se compense afin d'obtenir le moment magnétique total fixe dans tout l'intervalle. De plus, la variation légère des moments atomiques en fonction de la constante de réseau reflète le comportement ferromagnétique du composé RbMgO2 dans le domaine de variation.

Références

[1] R. Umamaheswari, D. Vijayalakshmi and G. Kalpana, Phys. B: Condens. Matter 448 (2014) 256.

[2] H. Rozale, A. Amar, A. Lakdja, A. Moukadem and A. Chahed, J. Magn. Magn. Mater. 336 (2013) 83.

[3]T. Malsawmtluanga, B. Vanlalruata and R. Thapa, J. Phys.: Conf. Ser. 765 (2016) 012018.

[4] H. Rozale, A. Lakdja, A. Amar, A. Chahed and O. Benhelal, Comp. Mater. Sci. 69 (2013) 229.

[5] Y. Gao and X. Wang, J. Korean Phys. Soc. 66 (2015) 1160.

[6] G.Y. Chun, W.X. Tian and H. Rozale, Chin. Phys. B 24 (2015) 067102.

[7] L. Zhang, X. Wang, H. Rozale, J.W. Lu and L.Y. Wang, J. Supercond. Nov.Magn. 28 (2015) 3701.

[8] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka and J. Luitz, WIEN2K, an augmented plane-wave + local orbitals program for calculating crystal properties (Karlheinz Schwarz, Techn. UniversitatWienna, Austria), 2001.ISBN 3-9501031-1-2.

[9] P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. 136 (1964) B864;

[10] W. Kohn and L. J. Sham, Phys. Rev. 140 (1965) A1133.

[11] Blaha, P. et al., *Wien2k*. An augmented plane wave + local orbitals program for calculating crystal properties, 2001.

[12] J.P. Perdew et al., Phys. Rev. Lett. 100, 136406 (2008)

[13] H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Phys. Rev.B 13 (1976) 5188.

[14] F. Birch, Phys. Rev. 71, (1947) 809-824.

[15] R. Umamaheswari, "Theoretical Investigation of *sp*-Half Metals in Heusler Structure" Thèse de Doctorat, Université ANNA, (2014).

Conclusion générale e

Conclusion générale

Dans ce travail, nous avons calculé les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de l'alliage Full Heusler RbMgO₂ dans la structure dite régulière (ou $L2_1$) de groupe d'espace n° 225 avec AlCu₂Mn comme prototype, en utilisant la méthode des ondes planes linéairement augmentées avec potentiel complet (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), en traitant l'énergie d'échange et corrélation par l'approximation du gradient généralisé (GGA PBEsol 2008). Cette méthode est afférée efficace pour l'étude des solides.

Nous avons tout d'abord calculé les propriétés structurales du composé RbMgO₂. On a ainsi déterminé le paramètre de maille, le module de compressibilité B et l'énergie de cohésion dans les deux types de structure régulière et inverse en utilisant l'approximation GGA PBEsol. Les résultats ont montré que la phase ferromagnétique (FM) est plus stable par rapport à celle non magnétique (NM).

Les propriétés électroniques telles que la structure de bande et la densité des états montrent clairement le caractère demi-métallique de l'alliage $RbMgO_2$ vu l'existence d'un gap indirect de valeur de 2.961 eV au niveau de Fermi dans la direction de spin up ainsi qu'un caractère métallique dans l'autre direction de spin. La valeur du gap demi-métallique G_{HM} est de 0.495 eV.

Ainsi, l'alliage Heusler RbMgO₂ est un vrai demi métal (true half-metal) ferromagnétique dont le moment magnétique total est de 1.0 μ_B . Il provient principalement de l'atome O et ceci est dû au décalage important entre les états de spins majoritaire et minoritaire des orbitales *p* de cet atome. La demi-métallicité du composé RbMgO₂ est conservée par une compression de 7.2 % et une expansion de 6.1 % du paramètre de maille par rapport à l'équilibre.

Les résultats obtenus sont comparables aux résultats théoriques et restent des prédictions qui peuvent être utilisées ou exploitées dans le domaine de la spintronique. Ceci permet de proposer notre composé comme un bon candidat pour les applications technologiques en spintronique et en plus particulier de l'utiliser dans les jonctions tunnels magnétiques.

Les résultats de notre travail sont très satisfaisants et nous ne pouvons que témoigner de la fiabilité du code WIEN2k et la puissance de la méthode FL/APW. Ils

nous encouragent à étudier l'alliage demi-métallique RbMgO₂ avec d'autres propriétés physiques.